








	<p><b>SI2347DS-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI2347DS-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 5A SOT-23</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI2347DS-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 90908 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2347DS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 5A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	90908 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 5A (Tc) 1.7W (Tc) Surface Mount SOT-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Verlustleistung (max)	1.7W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 3.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	705pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2347DS-T1-GE3CT

SI2347DS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2347DS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2347DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2347DS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2351DS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.8A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2347DS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 5A SOT-23</p>	 <p><b>SI2351DS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.8A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2343DS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 3.1A SOT-23</p>
 <p><b>SI2343DS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 3.1A SOT-23</p>	 <p><b>SI2350DS</b> VISHAY SI2350DS VISHAY</p>	 <p><b>SI2351DS</b> Vishay Precision Group SI2351DS VISHAY</p>	 <p><b>SI2351DS-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.8A SOT23-3</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI2337DS-T1-E3	↔ SI2337DS-T1-E3	⇒ SI2337DS-T1-GE3	D SI2337DS-T1-GE3	↔ SI2338DS-T1-E3
⊖ SI2338DS-T1-GE3	⊕ SI2338DS-T1-GE3	D SI2341DS	⇒ SI2341DS-T1-E3	↔ SI2341DS-T1-E3
⊕ SI2341DS-T1-GE3	⊖ SI2341DS-T1-GE3	⊕ SI2342DS-T1-E3	↔ SI2342DS-T1-GE3	↔ SI2342DS-T1-GE3
D SI2343ADS-T1-GE3	⊕ SI2343CDS	⊖ SI2343CDS-T1-E3	⊕ SI2343CDS-T1-GE3	↔ SI2343CDS-T1-GE3
⇒ SI2343DS-T1-E3	↔ SI2343DS-T1-E3	⊕ SI2343DS-T1-GE3	⊖ SI2343DS-T1-GE3	↔ SI2344DS-E3
↔ SI2347DS-T1-GE3	⇒ SI2351DS-T1-E3	D SI2351DS-T1-E3	⊕ SI2351DS-T1-GE3	⊖ SI2351DS-T1-GE3
⊕ SI2356DS-T1-GE3	D SI2356DS-T1-GE3	⇒ SI2365EDS	↔ SI2365EDS-T1-GE3	↔ SI2365EDS-T1-GE3
⊖ SI2366DS-T1-E3	⊕ SI2366DS-T1-GE	↔ SI2366DS-T1-GE3	⇒ SI2366DS-T1-GE3	↔ SI2367DS-T1-E3
⊕ SI2367DS-T1-GE3	⊖ SI2367DS-T1-GE3	⊕ SI2369DS-T1-GE3	D SI2369DS-T1-GE3	↔ SI2371EDS-T1-GE3
↔ SI2371EDS-T1-GE3	⊕ SI2372DS-T1-E3	⊖ SI2372DS-T1-GE3	⊕ SI2372DS-T1-GE3	↔ SI2374DS-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

